

# 2SD2180

シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形

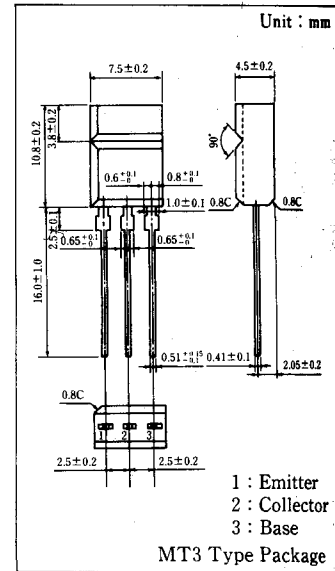
低周波出力増幅用

■ 特長

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。
- せん頭コレクタ電流 $I_{CP}$ が大きい。

■ 絶対最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	7	A
コレクタ電流	$I_C$	5	A
コレクタ損失	$P_C$	1.5	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	$\mu\text{A}$
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	50			V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	50			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=500\text{mA}$	120		340	
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2.5\text{A}$	80			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=100\text{mA}$		0.2	0.3	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=100\text{mA}$		0.85	1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=-50\text{mA}, f=200\text{MHz}$		80		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		50	70	pF

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.